

RFMD 新聞稿

公司聯繫:

RF Micro Devices Inc.
公關專員 Brian K. Cockman
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
Tel: +1 (336) 678-8945
bcockman@rfmd.com



RFMD® 由一級軍事供應商獲得氮化鎵訂單

此為 RFMD 氮化鎵功率放大器的首筆訂單

RFMD 的氮化鎵策略重點:

- 使 RFMD 之市場及客戶層達更多層面
- 發揮 RFMD 於複合式半導體及功率放大器的專長
- 延展 RFMD 的整體目標市場達 10 億美元，以涵蓋高功率半導體市場

北卡羅萊納州 GREENSBORO，2007 年 1 月 29 日—針對驅動行動通訊、設計及製造高效能無線電系統及解決方案的全球領導廠商 RF Micro Devices, Inc. (Nasdaq: RFMD) 今日宣佈，已從一級軍事供應商獲得首筆訂單，該筆訂單之產品為運用 RFMD 的氮化鎵(GaN) 高電子遷移率電晶體 (HEMT) 製程技術。RFMD 的氮化鎵技術可操作於廣泛的微波頻率範圍，使其成為多頻及寬頻應用的理想選擇。此訂單是 RFMD 氮化鎵功率放大器的首筆訂單。

此項訂單產品為 RFMD RF3825 PowerIC 寬頻功率放大器，其為一項 15 瓦元件，服務涵蓋率為 200MHz 至 1.9GHz。此 RF3825 能為軍事通訊大幅強化軟體界定無線電的頻寬。

RFMD 總裁暨 CEO Bob Bruggeworth 表示：「此首筆針對專利氮化鎵製程技術的訂單，代表 RFMD 在延伸客戶及市場多樣性上又跨越了一大步。由這些新市場所整合的營收機會大約為 10 億美元，其將提供 RFMD 非常有意義的新動力，以增加營收、毛利及利潤。我們的氮化鎵研發，部分已獲得美國政府的注意，而今日的發表，只是運用氮化鎵技術專利之許多軍事應用的一部分。此外，氮化鎵技術所適用的市場不僅限於軍事方面，更包括公共行動無線電、WiMAX 及 WCDMA 基地台。RFMD 於氮化鎵領域已建立了領導地位，其將能發揮我們領導業界的複合式半導體製造資產及設計工程智慧。

RFMD 技術長 Bill Pratt 表示：「氮化鎵具有獨特的電子專利，其為高功率、高效能應用提供了理想的技術。氮化鎵擁有明顯優於矽 LDMOS 技術的效率及功率密度，而這是氮化鎵在許多市場的主要競爭優勢。此外，氮化鎵技術能操作於非常廣泛的頻率範圍，而相對於其他如 LDMOS 等要求多重元件的製程技術，氮化鎵透過單一元件，以具成本效率的方式滿足了 WCDMA、WiMAX、軍事甘擾發射台及其他市場的多頻需求。」

RFMD 目前正於北卡羅來納州 Greensboro 的高量能製造廠中，運用其於複合式半導體的專業及於功率放大器的領導地位發展專利的氮化鎵技術。該公司是全球領導性的 AlGaAs HBT 及 GaAs pHEMT 製造商，並且是 InGaP HBT 之領導製造商，近期也發表了第二代 InGaP HBT 製程。RFMD 同樣也在蜂巢式功率放大器擁有全球領導製造地位。RFMD 於 2000 年將氮化鎵技商品化，並預期於 2007 上半年開始出貨。

RFMD 預計將於 2007 年進一步提升氮化鎵技術，包括具備高線性、寬頻及功率輸出達 200 瓦的高功率放大器(HPA)。

關於 RFMD: RF Micro Devices, Inc. (NASDAQ: RFMD)是針對驅動行動通訊應用，設計及製造高性能無線電系統及解決方案的全球領導廠商。RFMD 的功率放大器、轉換模組、行動電話收發器及系統單晶片(SOC)解決方案致能了全球的無線應用，提供強化的連結性、並支援今日及新一代行動電話、手機基地台、無線區域網路(WLAN)、WPAN 及全球定位系統 GPS 之先進功能。其公認在裝置產品上藝術等級的半導體技術，以及強大的 RF 系統專長，RFMD 是客戶的優先供應商，使全球領導行動裝置製造商，能提供滿足現今及未來市場需求的先進無線功能。

RFMD 總部設於北卡羅萊納州 Greensboro，已獲得 ISO 9001- 及 ISO 14001- 認證並具備全球性的工程、設計、銷售及服務據點。RFMD 於 NASDAQ 全美國市場以 RFMD 之交易代碼上市，如需進一步資訊，請參閱 RFMD 網站 www.rfmd.com

本新聞稿所包含“*前瞻性聲明*”，乃根據 1995 年「私人安全訴訟改革法案 (*Private Securities Litigation Reform Act of 1995*)」中的「免責規定 (*safe harbor*)」所為。縱使某些前瞻性聲明的表達有所不同，本文中的前瞻性聲明包括，但不限於關於本公司所擬計畫、目標、陳述及主張之聲明，其非歷史事實，典型以使用諸如：“也許”“將”“應該”“可能”“期望”“計畫”“預測”“相信”“預估”“預測”“潛力”“持續”及相似文字以界定。請注意此前瞻性聲明包含此間所表現管理者目前的判斷及期望，但我們的實際結果、事件及績效將可能與此前瞻性聲明之表達及暗示具有實質性的差異。我們並不會更新這些前瞻性聲明、或公開發表這些前瞻性聲明的修正結果，除非為聯邦證券法規(*federal securities laws*)之要求下。RF Micro Devices 的業務受多種風險和不確定性因素的影響，包括季度運營結果的易變性；無線市場的成長與發展速率；與以下方面相關的風險：晶圓製造、分子束外延與測試，裝配及測試、tape，捲線設備。以及吸引和保留熟練員工及培養領導者的能力，生產良率的易變性，採用新技術以降低成本、提高毛利率的能力，將新產品推向市場的能力；快速增加產能以適應產品需求增長的能力；對有限客戶的依賴，以及對第三方的依賴。在由美國證券交易委員會歸檔的 RF Micro Devices 10-K 報表的最新年度報告中，更詳細討論的這些以及其他風險和不確定性因素，可能導致實際結果和發展與此處任何一個前瞻性聲明中明示或暗示的意義存在本質性偏差。

RF MICRO DEVICES®, RFMD® 為 RFMD, LLC 註冊商標
其他所有商品名、商標及註冊商標則為其個別擁有者之財產